## CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

# **ELECTRONIQUE A 11** (code n° 26067)

**Seconde session** 

samedi 2 avril 2005 9 h – 12h

# sans documents

<u>Tout résultat donné sans unités sera considéré comme faux</u>
<u>Tout schéma électrique sans orientation des générateurs, des courants et des tensions</u> sera considéré comme faux.

Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.

### **EXERCICE 1: dopage (3 points)**

1) On donne un fragment du tableau de la classification périodique des éléments suivants :

ERIOD	GROUP																	
	1A	2A	38	48	58	6B	.78	8			18	28	3A	44	5A	64	7A	0
1	+1 -1 H										- 42							0 He 2
	LIGHT METALS						HET	ALS	7-1-1					NO	N META	LS	INER	T GAS
2	Li 3	Be 4		В	RITTL	 ε			DUC	(ILE		OW-	+3 B 5	**c	N-3	-2 O 8	-1 F 9	o. Ne 10
3	No 11	+2 Mg .12											+3 Al 13	+2 -4 *Si 14	•3 -3 •5 p •15	*4 -2 ** S 16	:}Cl	0 Ar 18
4	* ( K	+2 Ca 20	+3 Sc 21	;² ;³Τι 22	*2 *3 *5 *5 *5 *5	*2 *3 Cr 24	+2 +3 Mn +725	+2 +3Fe 26	*3Co 27	*3Ni 28	*1 *2 29	+2 Zn 30	+3 Ga 31	**Ge 32	*3 As 33	34	** Br 35	36
5	Rb 37	+2 Sr 38	+3 Y 39	7r 40	13 Nb 41	46 Mo 42	**Tc	+3 Ru 44	+3 Rh 45	**Pd 46	47	+2 Cd 48	13 In 49	50	*3 -2 *5Sb 51	"Te 52	53	0 Xe 54
6	Cs 55	+2 Ba 56	57-71	+4 Hf 72	+5 Ta 73	+6 W 74	14 17Re 75	+3 **Os 76	+3 +4 lr 77	12 14 Pt 78	*1 Au 79	*; Hg 80	†} T( B1	*2 *4 Pb 82	Bi 83	**Po 84	A1 85	0 Rn 86
7	•1 Fr 87	+2 Ra 88	★ 89- 103															

On considère un cristal de silicium intrinsèque de concentration intrinsèque  $n_i=10^{10}~\text{cm}^{-3}$  à 300K. On rappelle que le nombre d'atomes par cm $^{-3}$  du silicium est de 5  $10^{22}$ .

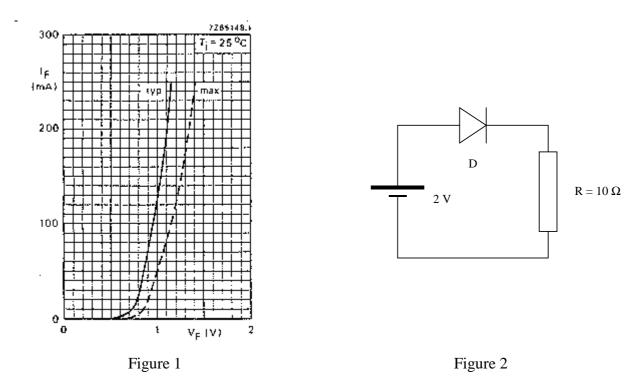
On dope le silicium au moyen d'atomes d'arsenic (As). On introduit dans le réseau cristallin un atome d'arsenic pour 2 10<sup>7</sup> atomes de silicium.

- a) Quel est le type de semi-conducteur obtenu?
- b) Quelle est la concentration des atomes d'arsenic?
- c) En déduire la concentration en électrons libres et en trous libres de ce semi-conducteur ainsi dopé.

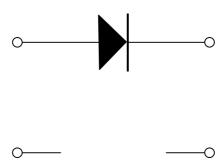
### **EXERCICE 2 : Circuit à diode (4 points).**

On considère une diode dont le constructeur donne la caractéristique de la figure 1 (on ne considérera que la caractéristique typique.) Cette diode est utilisée dans le schéma de la figure 2.

- 1) Déterminer graphiquement le point de fonctionnement de cette diode.
- 2) Donner les valeurs du courant et de la tension au point de fonctionnement.



- 3) En déduire en ce point de fonctionnement la résistance dynamique rd de la diode.
- 4) On désire linéariser cette caractéristique (typique) par deux segments de droite. Montrer que le schéma équivalent de la diode polarisée en direct se met sous la forme d'une résistance en série avec un générateur de tension. Dessiner ce schéma équivalent en précisant les valeurs numériques du générateur et de la résistance équivalente.



5) Remplacer dans le schéma du circuit de la figure 2 la diode D par son schéma équivalent déterminé à la question 4. Retrouver les valeurs du courant de repos en utilisant uniquement ce nouveau schéma. Conclusion ?

## **EXERCICE 3 : Redressement (4 points)**

Soit le circuit de la figure 1 suivante constitué d'un transformateur idéal de rapport 12/1, de diodes idéales et d'une charge  $R_L$  de 3,3  $k\Omega$ . Le secondaire est à point milieu. Le primaire est alimenté par une tension sinusoïdale de 220V efficace et de fréquence 50 Hz .

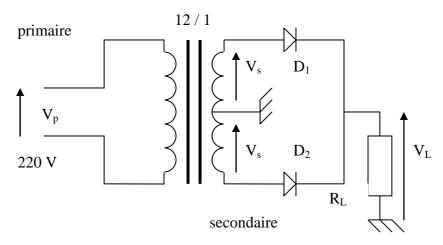


Figure 1

- 1) Représenter sur un même graphe l'allure de la tension d'entrée au primaire et de la tension de sortie  $V_L$  sur la charge. On précisera sur le graphe l'état des diodes.
- 2) Quelle est la tension maximale inverse supportée par chaque diode et quel est le courant direct maximal qui traverse chaque diode ?
- 3) Quelle est la valeur moyenne de la tension de sortie. (On ne demande pas de refaire la démonstration du calcul de la valeur moyenne !).
- 4) Pour avoir une tension de sortie qui soit plus proche d'une tension continue, quel élément faudrait-il ajouter au montage ? Dessiner le nouveau schéma.

# **EXERCICE 4 Amplification (9 points)**

# Les parties I, II, III sont indépendantes

On se propose d'étudier le montage élémentaire suivant réalisé à partir d'une alimentation continue et d'un transistor bipolaire.

Les caractéristiques statiques du transistor sont les suivantes :

$$V_{BE~on}=0.7~V$$
;  $\beta_{typ}=100.$ 

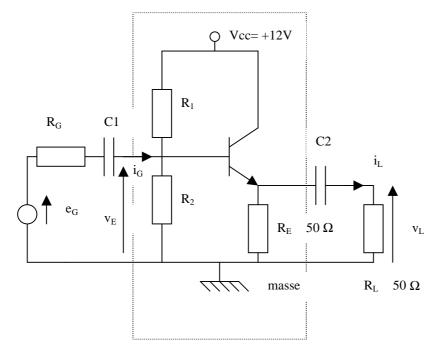


Figure 1

#### I) **QUESTIONS PRELIMINAIRES**

- 1) Quel est le montage élémentaire de base réalisé avec ce transistor ? Justifier votre choix.
- 2) Rappeler en quelques lignes les propriétés fondamentales d'un tel étage amplificateur.
- 3) Quel est le rôle des condensateurs C1 et C2 ?

## II) POLARISATION.

- 1) Dessiner le schéma du montage valable pour la polarisation.
- 2) Donner l'expression de la droite de charge et représenter cette droite sur la copie.
- 3) On choisit le point de fonctionnement tel que  $V_{CE} = 4V$ . Que vaut le courant  $I_C$ ?
- 4) Donner l'expression de la droite de charge dynamique et représenter cette droite sur le même graphe que celui de la question 3. (voir figure 1)
- 5) Que peut-on en conclure pour le choix du point de repos ?
- 6) Pour déterminer les valeurs des résistances R<sub>1</sub> et R<sub>2</sub> on procèdera de la manière suivante :

La résistance équivalente à  $R_1$  et  $R_2$  disposées en parallèle est  $R1//R2 = R = 1k\Omega$ 

Dessiner le schéma de Thévenin équivalent à gauche de la base du transistor.

En déduire les valeurs de  $R_1$  et de  $R_2$ .

### III) ETUDE EN PETITS SIGNAUX AUX FREQUENCES MOYENNES

On admettra qu'aux fréquences de travail les condensateurs n'interviennent pas. Les paramètres dynamiques du transistor sont les suivants :

 $h_{11e} = 15 \Omega$ ;  $h_{12e} = 0$ ;  $h_{21e} = \beta = 100$ ;  $h_{22e} = 0 \Omega^{-1}$ .

Les résistances du montage sont :  $R_1//R_2 = 1k\Omega$ ;  $R_G = 100 \Omega$ ;  $R_E = R_L = 50 \Omega$ .

- 1) Dessiner le schéma équivalent en petits signaux de l'ensemble du montage.
- 2) Calculer le gain en tension  $v_L/v_E$ ; l'impédance d'entrée ; le gain composite en tension  $v_L/e_G$ ; et le gain en courant  $i_L/i_G$ .
- 3) Calculer la résistance de sortie du montage.

### **EXERCICE 5 : filtrage utilisant un amplificateur opérationnel (7 points)**

On désire réaliser un filtre actif au moyen d'un seul amplificateur opérationnel. On supposera dans les questions 1 à 5 que l'amplificateur opérationnel peut être considéré comme idéal. Le schéma est celui de la figure 1 ci-dessous.

Les spécifications du filtre recherché sont les suivantes:

Fréquence de cassure du diagramme asymptotique basse = 100 Hz; Fréquence de cassure du diagramme asymptotique haute = 10 kHz; Gain en décibels dans la région médiane = 20 dB.

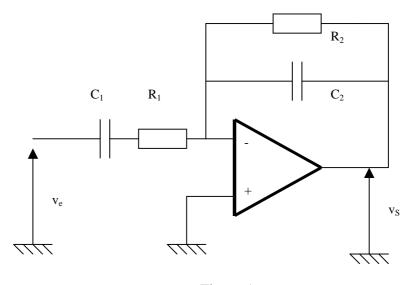


Figure 1

On se place en régime sinusoïdal permanent.

- 1) Quel est l'ordre du filtre et quel est le type de filtre réalisé ? (justifier votre réponse)
- 2) Déterminer la fonction de transfert  $Vs/Ve = T(j\omega)$  de ce filtre en fonction de  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $C_1$  et  $C_2$ .

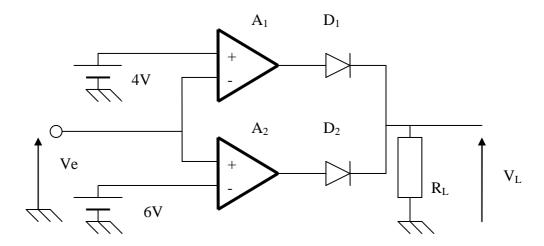
Montrer qu'elle se met sous la forme:  $T(j\omega) = G_0 \cdot \frac{j\frac{\omega}{\omega_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_1}} \cdot \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}}$ 

- 3) Exprimer  $G_0$  en fonction de  $R_1$  et  $R_2$  et les pulsations  $\omega_1$  et  $\omega_2$  en fonction des produits  $R_1C_1$  et  $R_2$   $C_2$ .
- 4) Dessiner l'allure du diagramme asymptotique de Bode du module de cette fonction de transfert en utilisant les données numériques des spécifications décrites au début de l'énoncé.
- 5) Déterminer les valeurs numériques des éléments  $R_2$   $C_1$  et  $C_2$ . (on prendra  $R_1 = 1k\Omega$ ).
- 6) L'amplificateur opérationnel n'est plus idéal et son gain s'exprime en fonction de la fréquence de la manière suivante :  $A_d = \frac{A_0}{1+j\frac{f}{f_0}}$ . Le gain  $A_0$  de l'amplificateur

opérationnel réel est de 2 10<sup>5</sup>. Sa fréquence de coupure f<sub>0</sub> est de 10 Hz. Cet amplificateur peut-il être utilisé dans le montage précédent sans modifier ses propriétés fréquentielles ?

## **EXERCICE 6: Comparateur (3 points)**

Soit le circuit suivant utilisant deux amplificateurs opérationnels supposés idéaux et de diodes idéales.



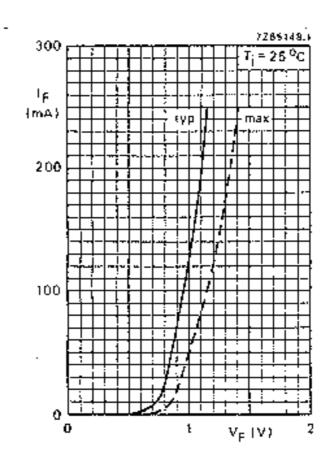
La tension continue d'alimentation des amplificateurs est double  $\pm$   $V_{CC}=\pm$  12V. (alimentation non représentée sur le schéma).

La tension d'entrée Ve peut varier entre 0V et 10V.

- 1) Tracer la caractéristique de transfert de ce circuit Vs = f(Ve) (On portera Ve en abscisse et Vs en ordonnée). On pourra préciser le fonctionnement du dispositif suivant les valeurs de la tension d'entrée.
- 2) Ce système présente-t-il une hystérésis?

Numéro de Copie :

# **EXERCICE 2 Circuit à diode**



# **EXERCICE 3 : Redressement**

